

元気が出る原価管理システム紹介

一橋大学大学院商学研究科 尾畑 裕



目次

- 1.はじめに
- 2.PSLXとは何か
- 3.元気の出る原価管理システム構築手順
- 4.工程の理解
- 5.オブジェクト図
- 6.システムイメージ
- 7.システムのメリット特徴
- 8.今後の課題



1.はじめに



半導体産業に適した 「元気が出る原価管理システム」 のプロトタイプ構築

JEITA·STRJと一橋大学尾畑研究室との共同プロジェクト

オブジェクト指向原価計算のモデルを使って 半導体前工程の原価管理システムのモデル を構築



元気のでる原価管理システム

エンジニアの活動の財務的な成果を事前 に予測することができる

経営者が、エンジニアの活動を正当に評価できる

ベースのモデルはPSLXのモデルを拡張



2. PSLXとは



PSLXコンソーシアム

PSLXコンソーシアムのページ

http://www.pslx.org/

PSLXコンソーシアム

インターネット上での利用を前提とした、生産計画・スケジューリングの標準化を行う非営利団体



PSLXの ドメイン・オブジェクト・モデル

PSLXにおけるドメイン・オブジェクト・モデルを拡張して、原価計算用ドメイン・オブジェクト・モデルを構築

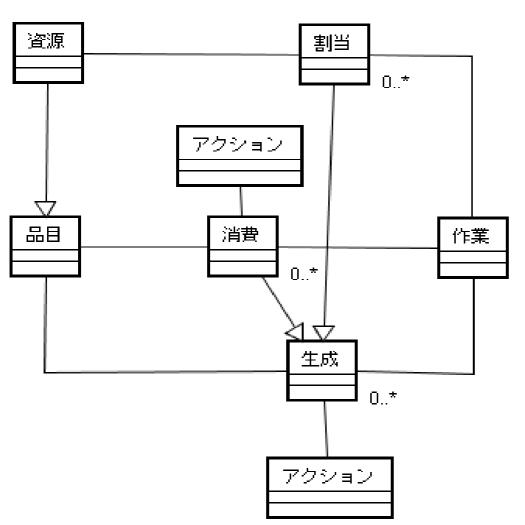
PSLXのドメイン・オブジェクト・モデル の基本形

- 作業が中心となって、作業が品目を消費し、 作業が品目を生成すると考える。
- そして、作業には、資源(設備および作業者) が割り当てられる。

生成されるのは、具体的な品目であり、段 取作業のように、なにも生成しない作業もあ る



PSLXのドメインオブジェクト(中心部分)



アクションが数量情報 をもつ(在庫を増減さ せるという意味)



3.元気が出る原価管理システム」構築手順



「元気が出る原価管理システム」構築手順

- 1.半導体製造ラインの工程理解
- 2.PCDT(JEITA)のサンプルデータを
- 3.ドメイン・オブジェクトモデルの構築
- 4.ユーザー・インターフェイスの模索
- 5. プロトタイプの構築



4. 工程の理解



半導体製造ラインの工程例 (JEITA提供)

大工程の例

M2_層間膜形成

M2_Via露光

M2_Via加工

M2_ILD露光

M2_ILD加工

M2 メタル形成

M2 メタル研磨

M2_電気的特性検査



M2_層間膜形成

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_層間膜形	ウェハ洗浄	洗浄装置A	レシピ1
成	ハードマスク成 膜	プラズマCVD装置A	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1
	Low-K塗布	塗布装置A	レシピ1
	キュア	アニール装置A	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1
	外観検査	外観検査装置A	レシピ1
	ハードマスク成 膜	プラズマCVD装置B	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1



M2_Via**露光**

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_Via 露光	露光·現像	インライン露光装置A	レシピ1
	寸法検査	電子顕微鏡A	レシピ1
	合せ検査	合せ検査装置A	レシピ1
	外観検査	外観検査装置A	レシピ2



M2_Via加工

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_Via加工	エッチング1	ドライエッチ装置A	レシピ1
	エッチング2	ドライエッチ装置B	レシピ1
	レジスト剥離1	アッシング装置A	レシピ1
	レジスト剥離2	洗浄装置B	レシピ1
	外観検査	外観検査装置A	レシピ3
	寸法検査	電子顕微鏡A	レシピ1



M2_ILD露光

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_ILD露光	露光·現像	インライン露光装置A	レシピ2
	寸法検査	電子顕微鏡A	レシピ2
	合せ検査	合せ検査装置A	レシピ2
	外観検査	外観検査装置A	レシピ2



M2_ILD加工

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_ILD加工	エッチング1	ドライエッチ装置B	レシピ2
	エッチング2	ドライエッチ装置A	レシピ2
	エッチング3	ドライエッチ装置B	レシピ3
	レジスト剥離1	アッシング装置A	レシピ2
	レジスト剥離2	洗浄装置B	レシピ2
	エッチ検査	原子間力式顕微鏡A	レシピ1
	寸法検査	電子顕微鏡A	レシピ2
	外観検査	外観検査装置A	レシピ2



M2_メタル形成

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_メ タル形成	ウェハ洗浄	洗浄装置A	レシピ2
	バリアシード膜 形成	メタルCVD装置A	レシピ1
	配線膜形成	めっき装置A	レシピ1



M2_メタル研磨

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_メ タル 研磨	メタル研磨	CMP装置A	レシピ1
	ウェハ洗浄	洗浄装置A	レシピ3
	寸法検査	電子顕微鏡A	レシピ3
	外観検査	外観検査装置A	レシピ2
	キュア	アニール装置B	レシピ1



M2_メタル研磨

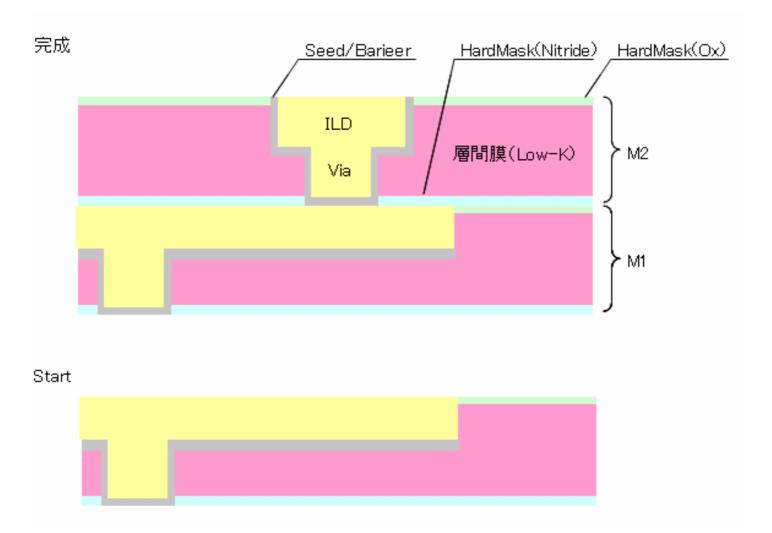
大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_電気的特 性検査	PARM_TEST	マイクロプロ ーブ 装置 A	レシピ1



サンプル工程を図で示す (JEITA提供)

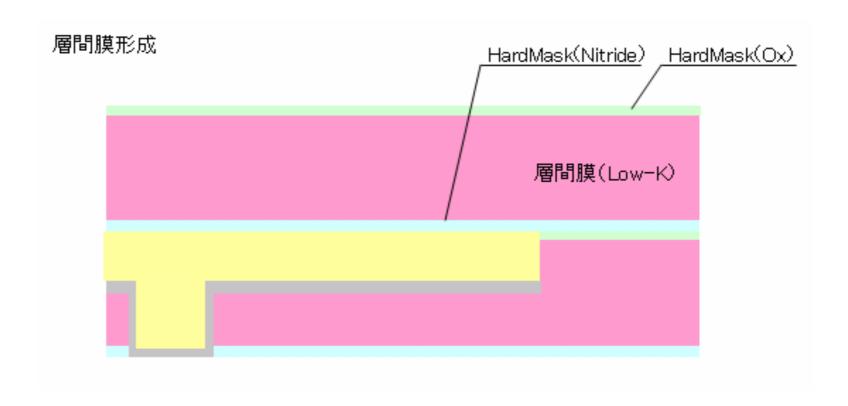


半導体製造ラインの工程理解



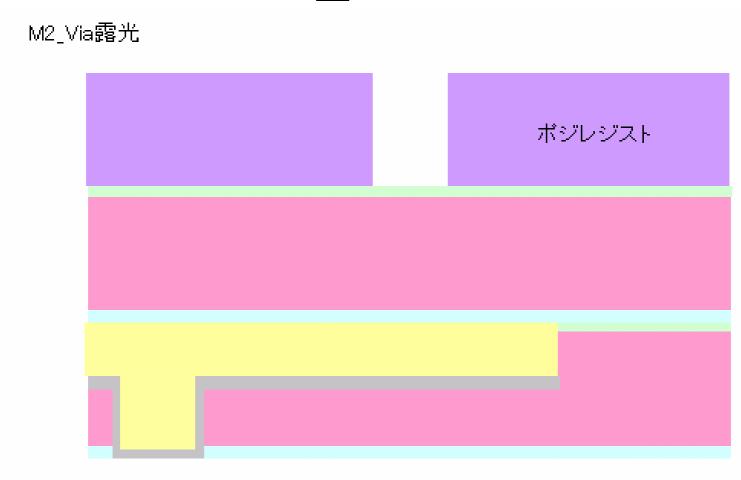


層間膜形成



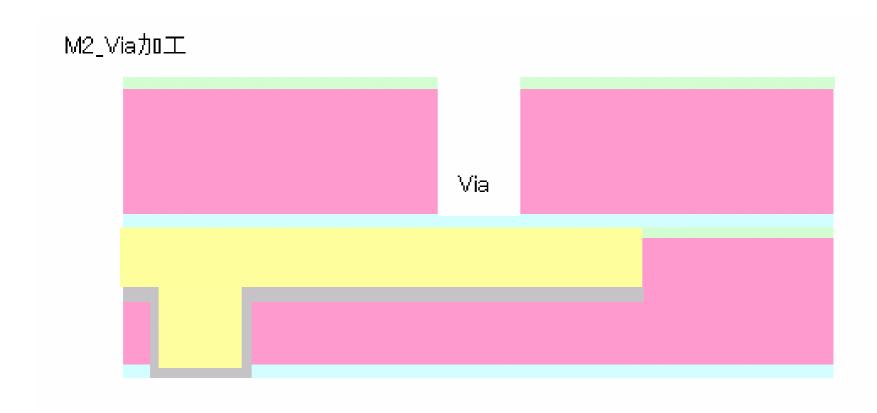


M2_Via露光



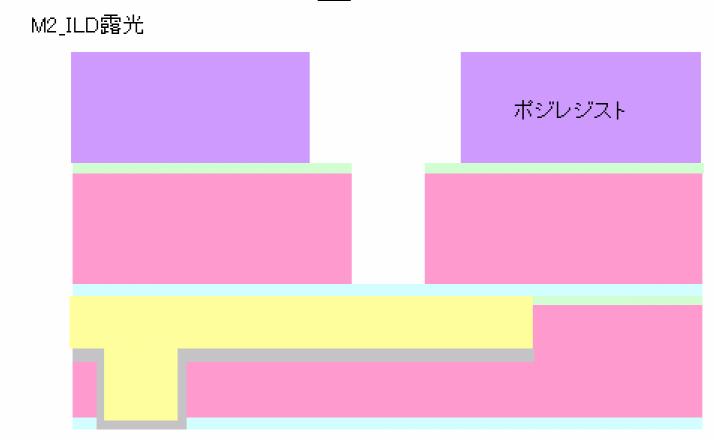


M2_Via加工





M2_ILD露光



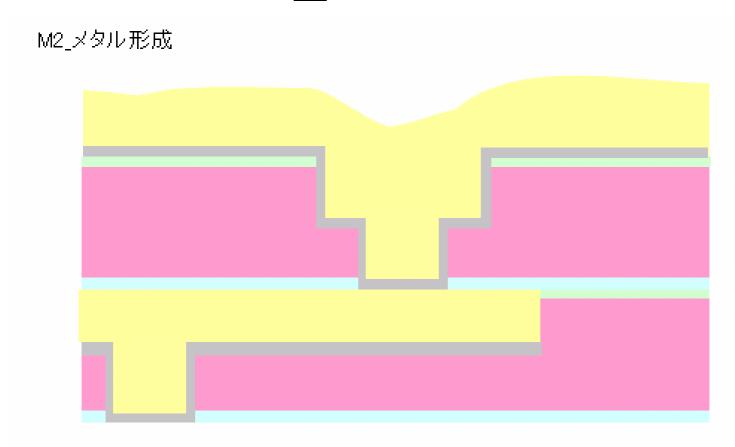


M2_ILD加工

M2_ILD加工 ILD

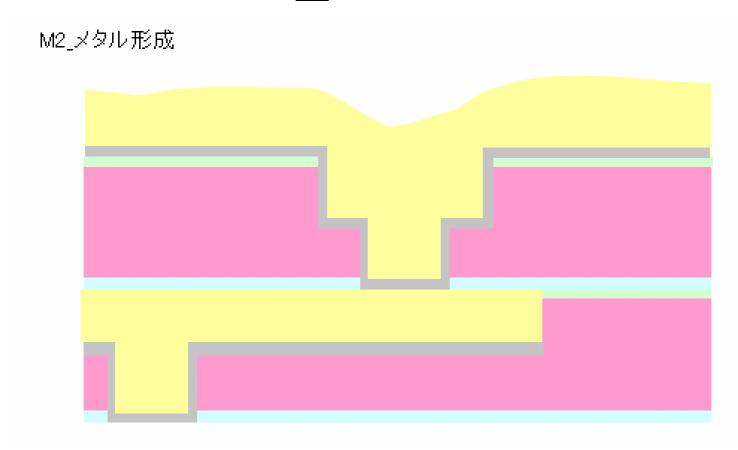


M2_メタル形成



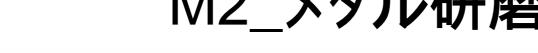


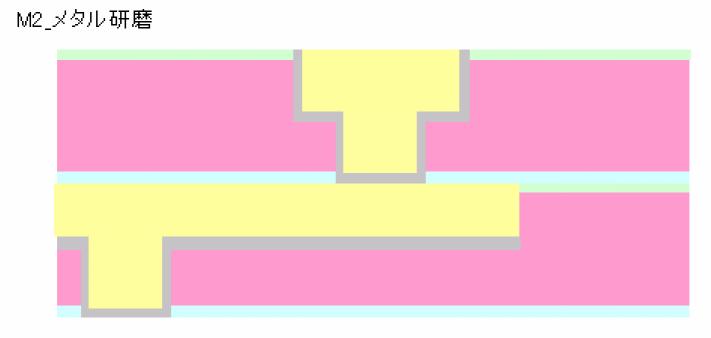
M2_メタル形成





M2_メタル研磨







5.オブジェクト図による例示 (JEITA提供データによる)



PCDTデータ (JEITA提供)

PCDT(Process Cost Design Tool)
 Rev1.03bランタイム版 Copyright:セイコーエプソン(株) 用で読み込めるデータの形式で、JEITAより、サンプルデータの提供を受けた。

以下、M2_層間膜形成を例にオブジェクト図を作成

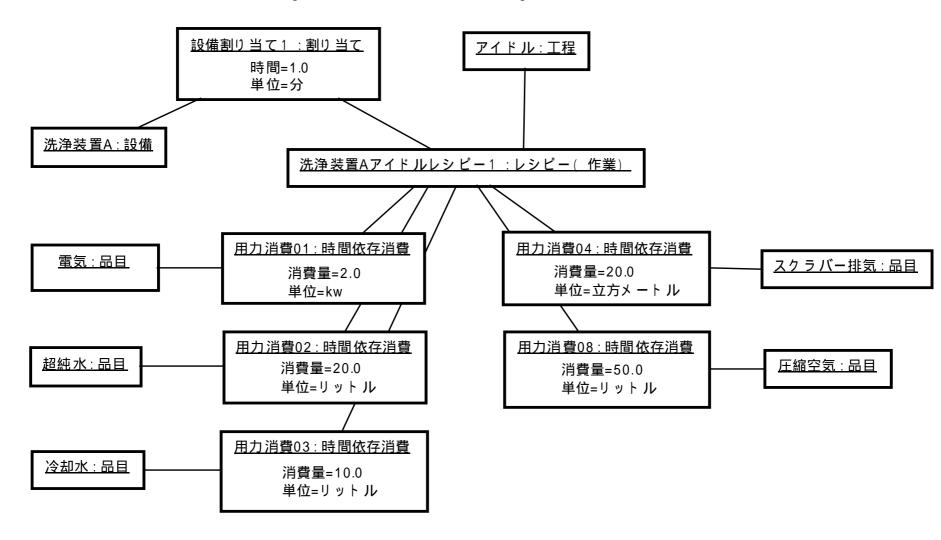


M2_層間膜形成を例に オブジェクト図を作成

大工程	小工程	処理装置	レシピ名称
M2_層間膜	ウェハ洗浄	洗浄装置A	レシピ1
形成	ハードマスク 成膜	プラズマCVD装置 A	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1
	Low-K塗布	塗布装置A	レシピ1
	キュア	アニール装置A	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1
	外観検査	外観検査装置A	レシピ1
	ハードマスク 成膜	プラズマCVD装置 B	レシピ1
	膜厚検査	膜厚測定器A	レシピ1

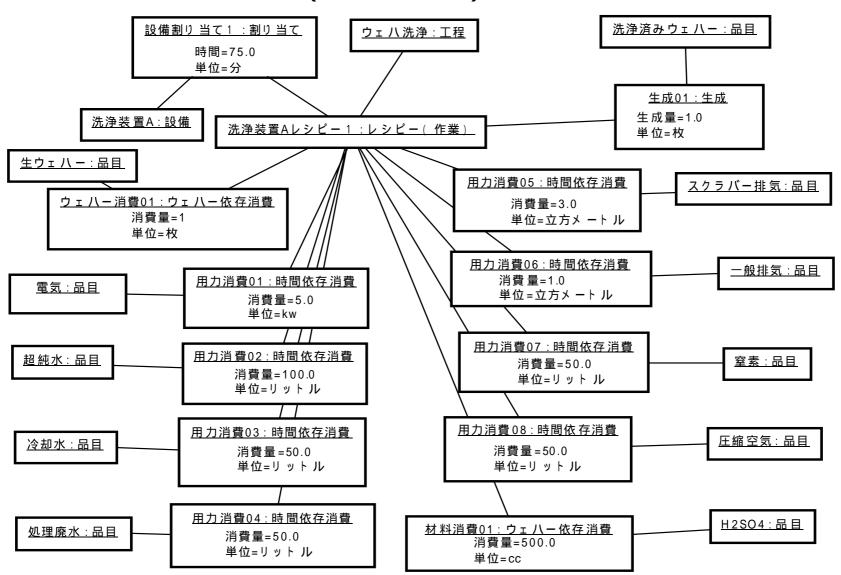


ウェハ洗浄(アイドル時)のオブジェクト図



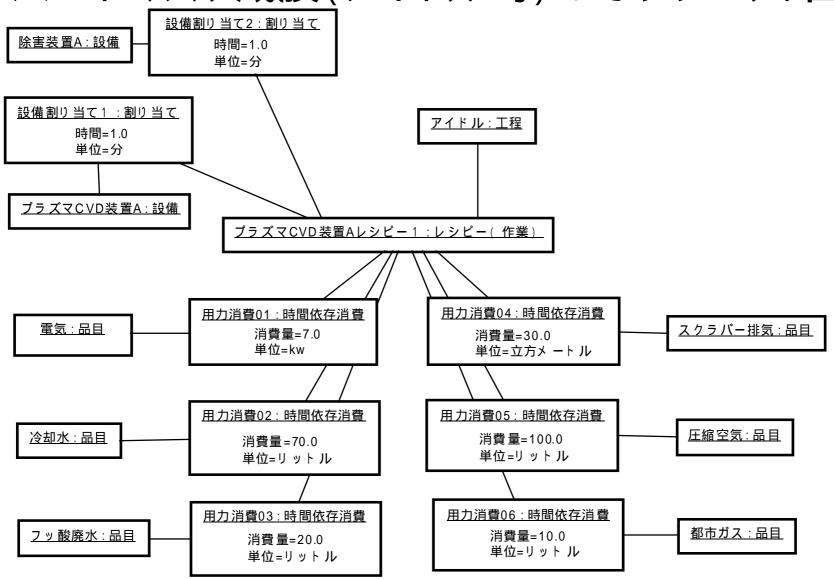


ウェハ洗浄(処理時)のオブジェクト図



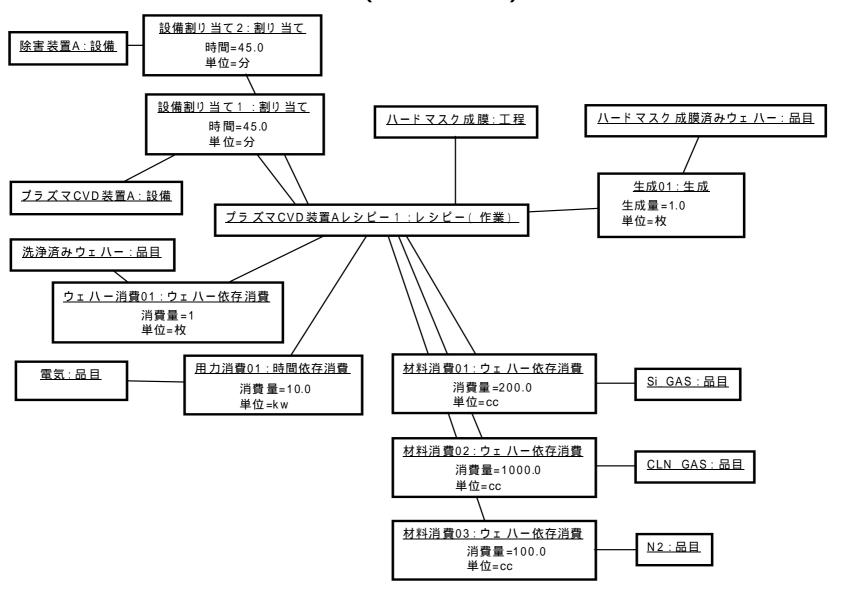


ハードマスク成膜(アイドル時)のオブジェクト図



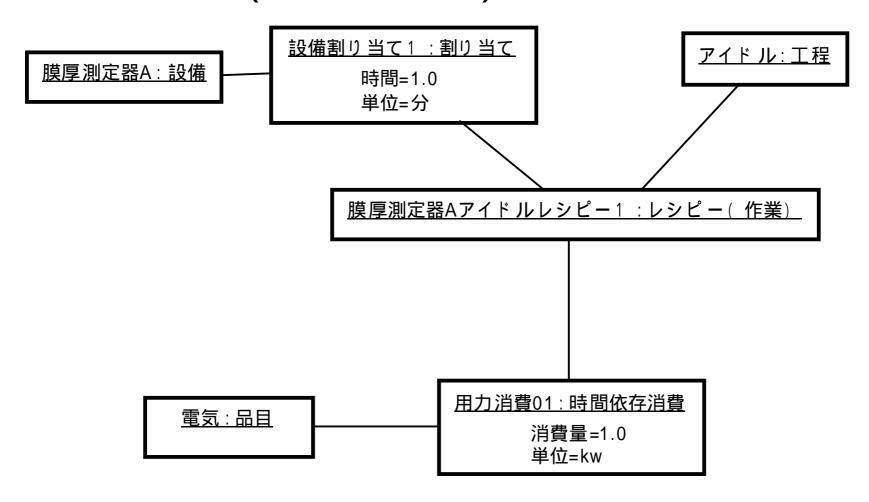


ハードマスク成膜(処理時)のオブジェクト図



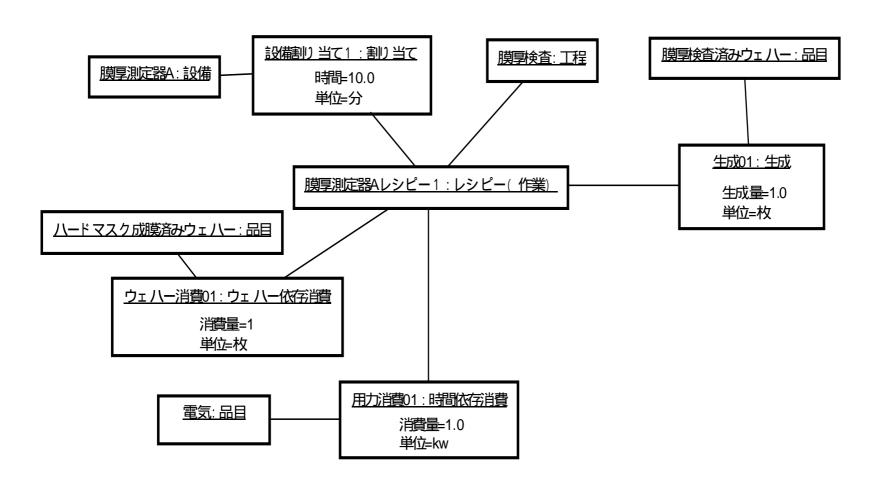


膜厚検査(アイドル時)のオブジェクト図



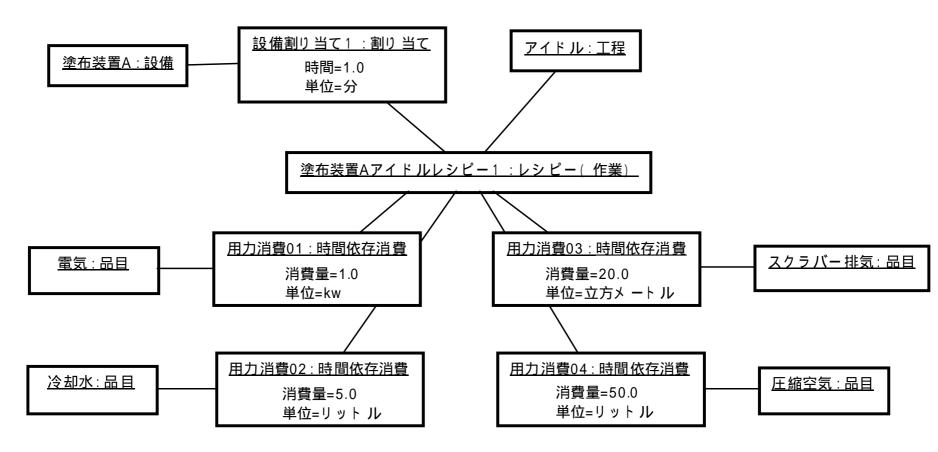


膜厚検査(処理時)のオブジェクト図



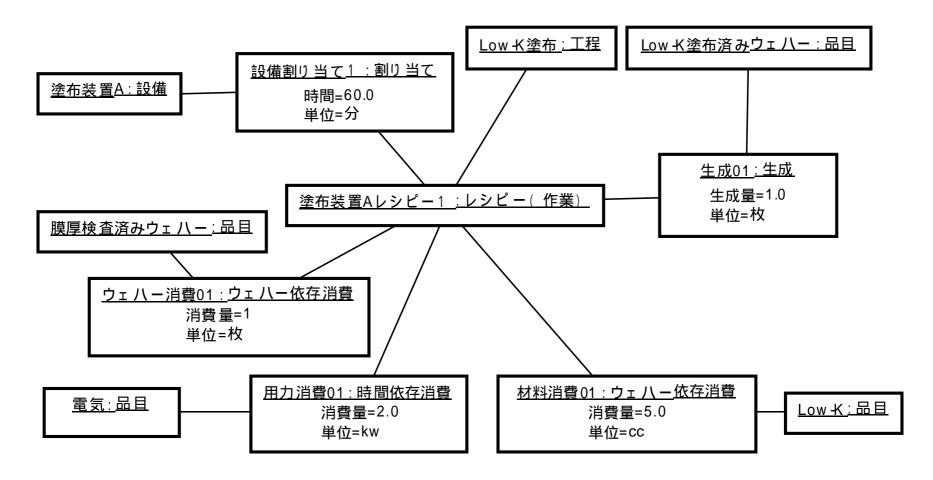


Low-K塗布(アイドル時)のオブジェクト図



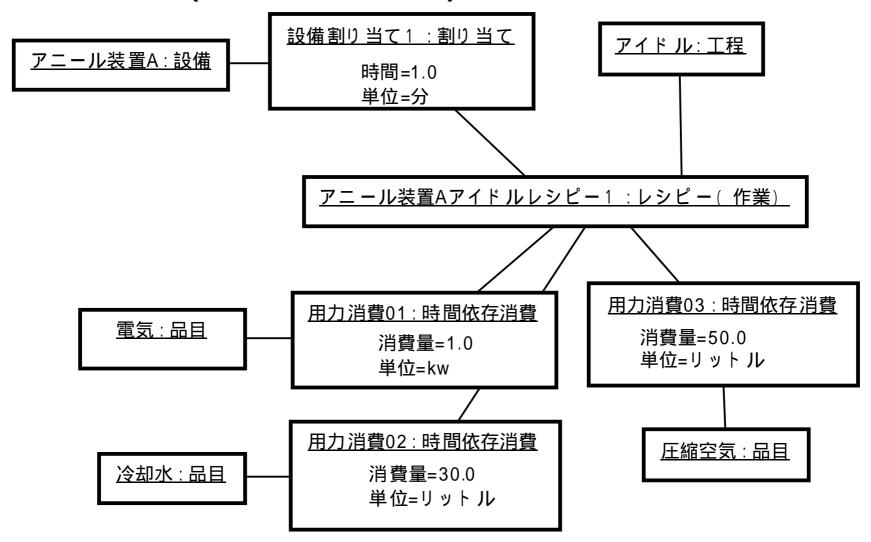


Low-K塗布(処理時)のオブジェクト図



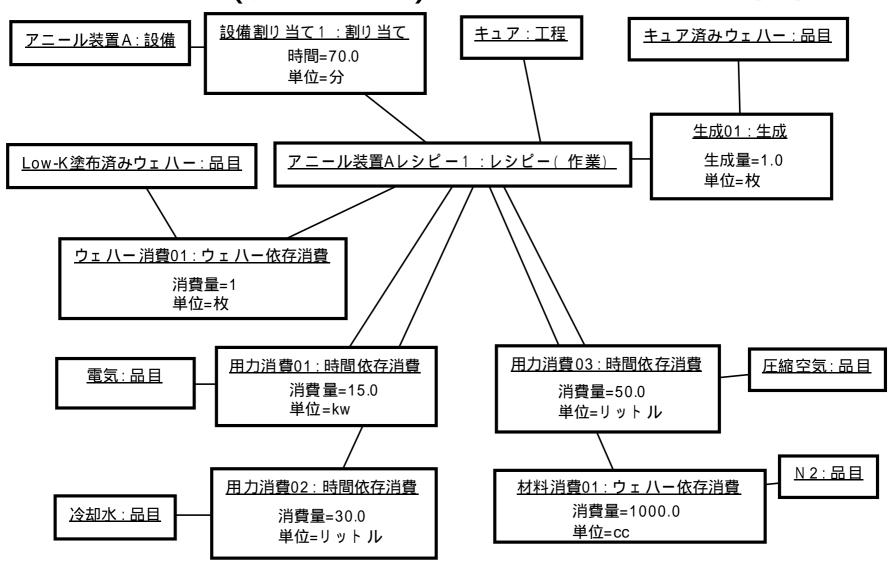


キュア(アイドル時)のオブジェクト図



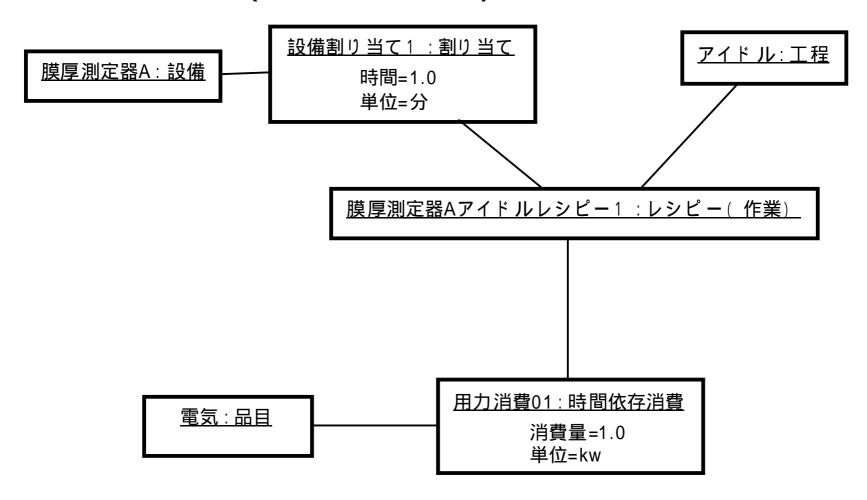


キュア(処理時)のオブジェクト図



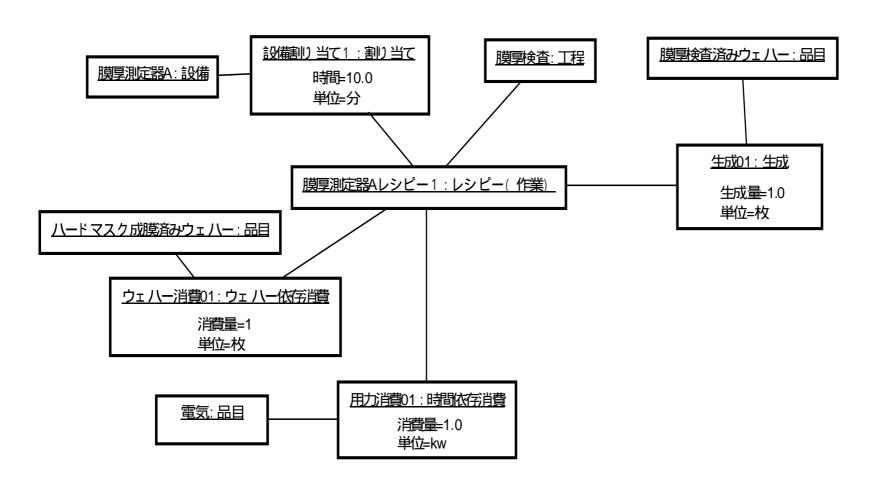


膜厚検査(アイドル時)のオブジェクト図



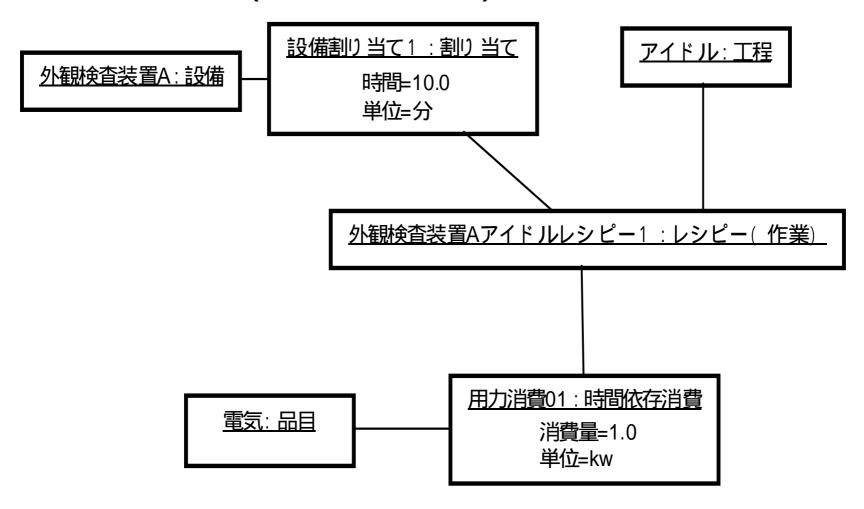


膜厚検査(処理時)のオブジェクト図



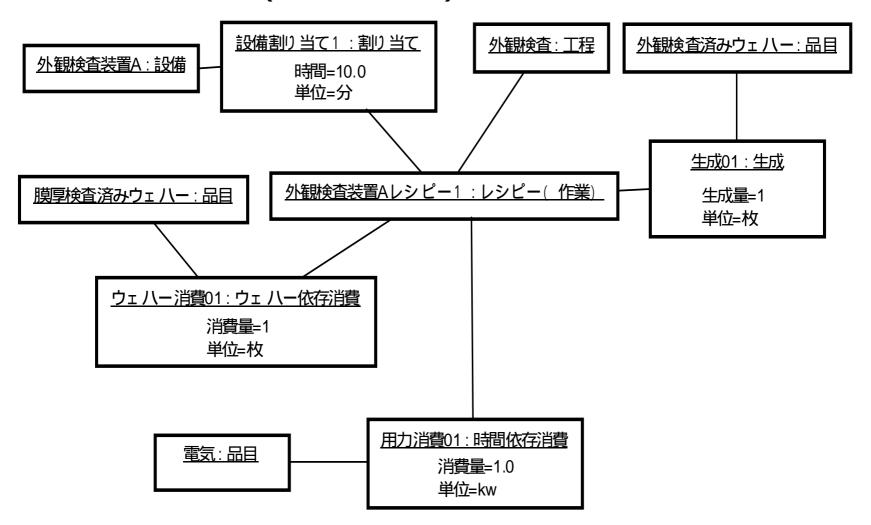


外観検査(アイドル時)のオブジェクト図



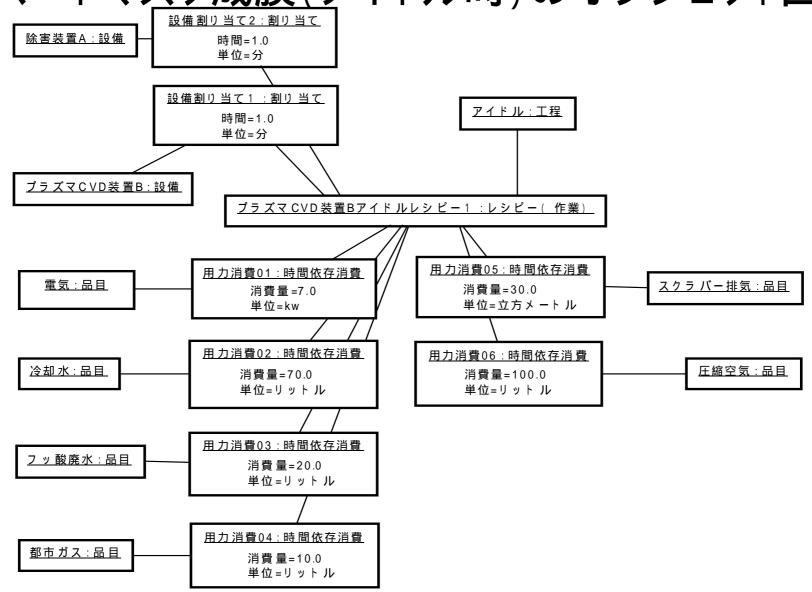


外観検査(処理時)のオブジェクト図



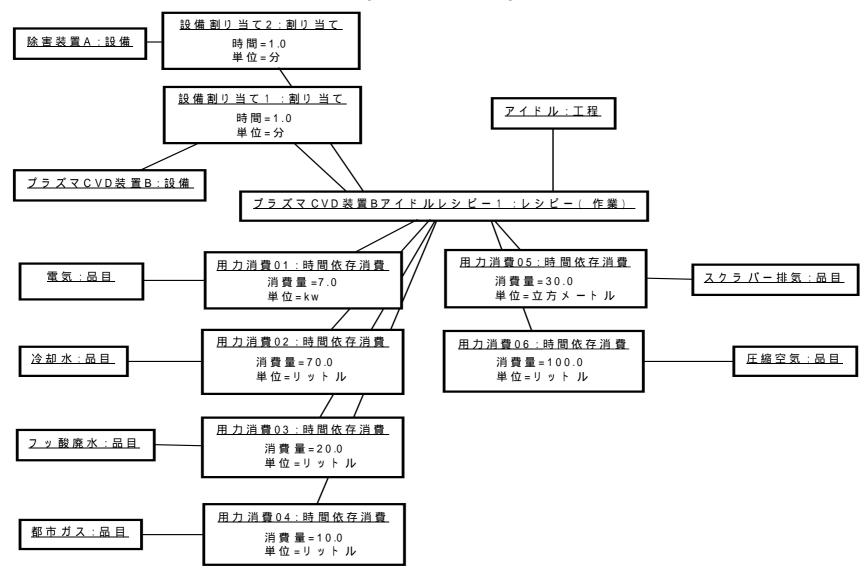


ハードマスク成膜(アイドル時)のオブジェクト図



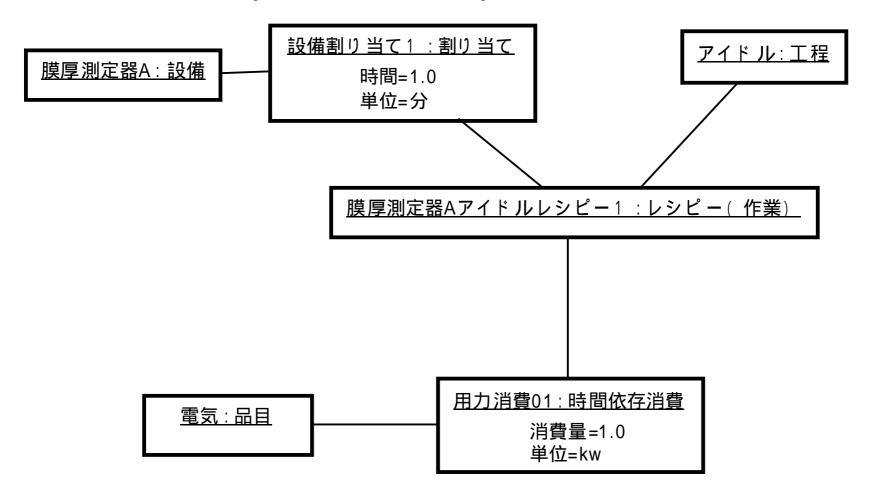


ハードマスク成膜(処理時)のオブジェクト図



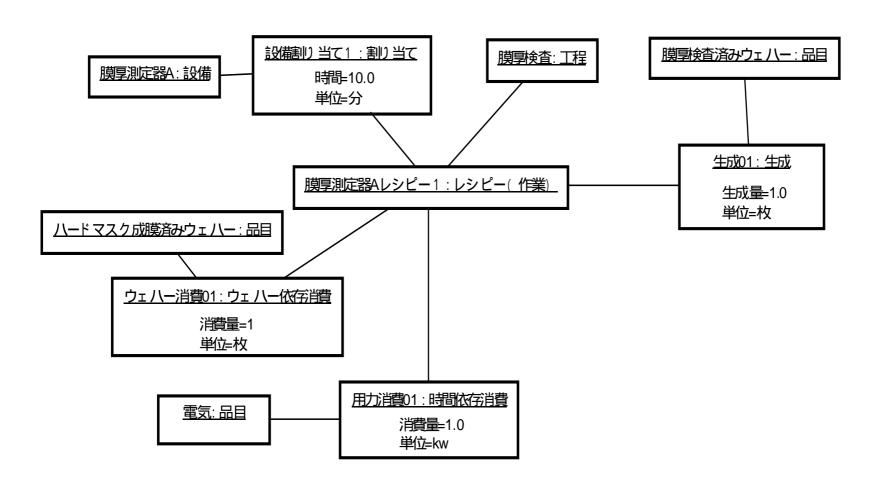


膜厚検査(アイドル時)のオブジェクト図



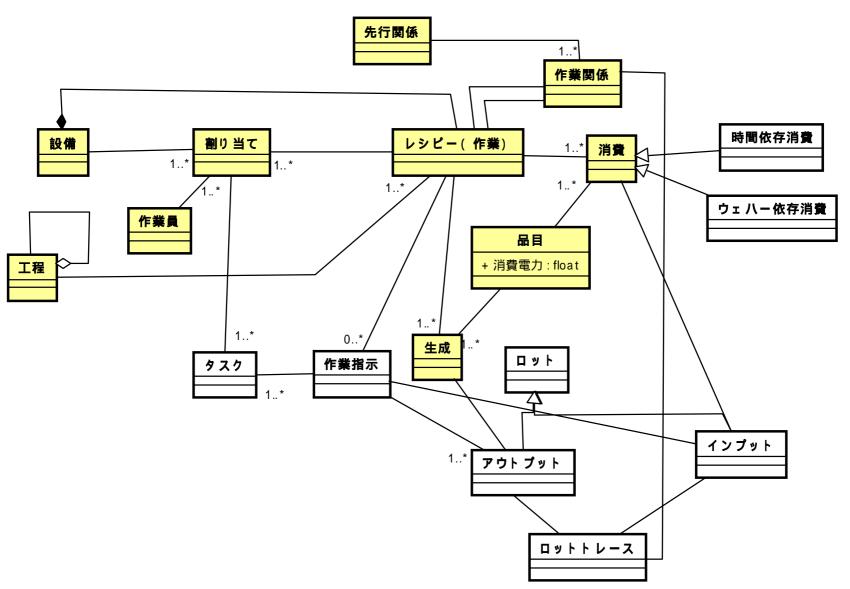


膜厚検査(処理時)のオブジェクト図





抽象化してクラス図に理する





6.システムイメージ

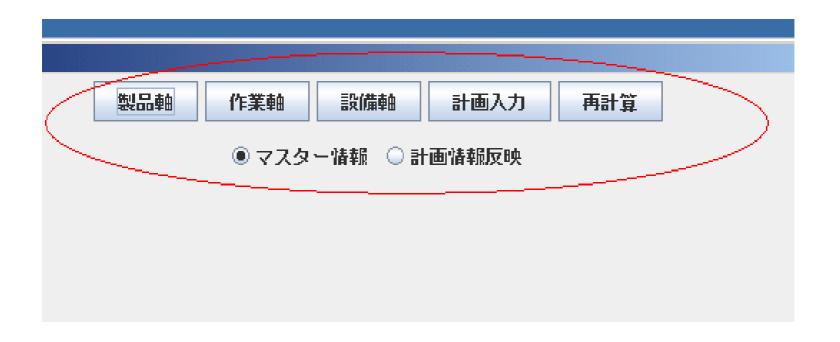






システムの特徴1(軸の選択)

製品軸、作業軸(レシピー軸)、設備軸を選択できる

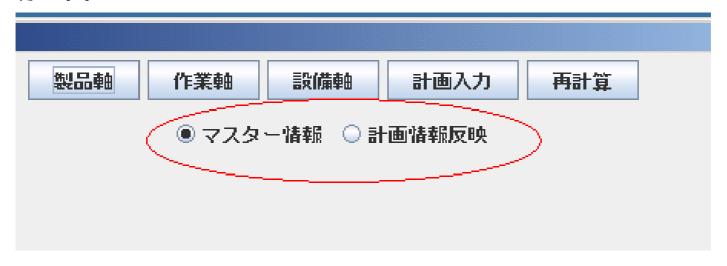




システムの特徴2

(マスタ情報とインスタンス情報の切り替え)

マスタ情報(1ウエハーあたり、1分あたりの計算)とインスタンス情報(月間生産枚数を反映した計算)とを切り替えることができる





システムの特徴3

(計算方法の選択)

計算要素を選択できる 減価償却費の処理方法の選択 アイドル用力の処理方法の選択

育人費目

☑ レシビ用力費 ☑ 減価償却費

☑ アイドル用力費

償却費の処理

◉ 設備毎に配賦 -

○ 全体配賦 ○ ボトルネック配賦

機会原価で配賦

アイドル用力の処理 🌑 設備毎に配賦 🔘 全体配賦



システムの特徴4 (ドリルダウン機能)

総括的情報から詳細情報へドリルダウンが可能

	[レンスト乖離])冼尹装直 B	1200	700.0		
	外観検査3	外観検査装置A	1200	200.0		
	露光現像2	インライン露光装	1200	900.0		
	寸法検査2	電子顕微鏡A	2400	800.0		
	合せ検査2	合わせ検査装置A	1200	500.0		
	エッチング2	ドライエッチ装置A	1200	1400.0		
	エッチング2	ドライエッチ装置B	1200	700.0		
	レジス <u>ト乖離2</u>	アッシング装置A	1200	700.0		
	セジスト乖離2	洗浄装置B	1200	700.0		
	エッチ検査1	原子間力式顕微鏡A	4,200	400.0		
	ウェハ洗浄2	洗浄装置A	1200	1200.0	•	
レシビ展開 設備展開						

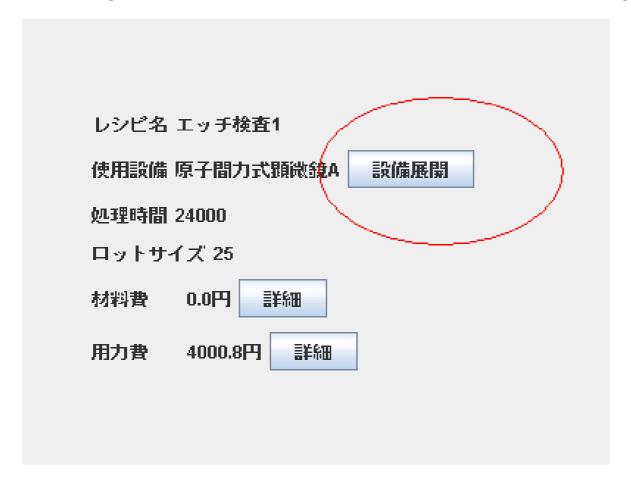


システムの特徴4(ドリルダウン機能)続き





システムの特徴5 (絞り込み後視点切り替え)





7.システムのメリット特徴



改善効果のシミュレーション

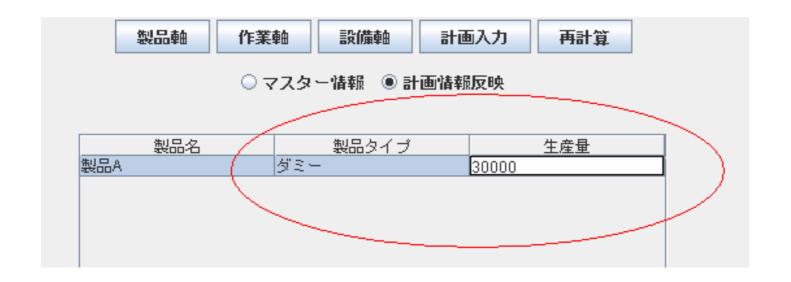
- レシピーのプロセスタイムを変更してみる エンジニアの活動の財務的な成果を事前に予測

製品軸 作簿	美軸 設備軸 計	画入力 再計算						
117	artiment ar	171174						
● マスター情報 ○ 計画情報反映								
レシビ名	使用設備	プロセスタイム						
露光現像1	インライン露光装置A	45.0						
露光現像2	インライン露光装置▲	45.0						
バリアシード膜形成1	メタルCVD装置A	70.0						
メタル研磨1	CMP装置A	60.D						
エッチング1	ドライエッチ装置A	55.0						
エッチング1	ドライエッチ装置B	35.0						
エッチング2	ドライエッチ装置B	35.0						
エルエンバク	はニイナル土壮罕∧	70.0						



シミュレーション機能について

生産量を設定





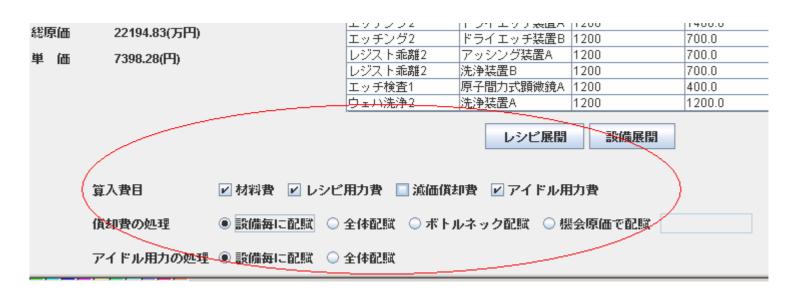
シミュレーション機能について

作業軸のマスタ情報を変更



計算方法の変更により経営者が改善 効果を的確に把握できる

減価償却費をいれないで計算してみる ボトルネック設備の時間だけですべての減価償却 費を計算(あるいはボトルネック設備の時間に任 意の機会原価レートを設定)





8. 今後の課題



今後の課題

- 1.エージェントの充実(計算仮定の充実。さらに多様なシミュレーションに対応。データベース連動等。)
- 2.人件費、業務アクティビティの跡付け(ABC/ABM機能)
- 3. 処理パラメータの変更によるシミュレーション
- 4.スケジューラーとの連携(ロットごとの計画原価)
- 5.ロット別の実際原価の計算
- 6.モデルの一般化ーPSLXとの連携



PSLXのプロジェクト

PSLXのプロジェクトとしても位置づけられている「半導体産業におけるPSLX対応オブジェクト指向原価管理システム」(2004-)
 課題

原価管理用ドメイン・オブジェクトの構築 標準的な原価計算用メッセージング規約の策 定

http://www.pslx.org/ml/allmember/msg00079.html